© 2009 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 61.05.cf, 61.43.Hv, 81.07.Pr, 81.20.Fw, 82.33.Ln, 82.70.Gg

# Структура та діелектричні властивості боросилікофосфатних золь—ґель нанокомпозитів

В. В. Клепко, Ю. П. Гомза, Ю. А. Куницький\*, А. П. Шпак\*\*

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Харківське шосе, 48, 02160 Київ, Україна \*Технічний центр НАН України, вул. Покровська, 13, 04070 Київ, Україна \*\*Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Акад. Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

На основі золь-ґель-технології розроблено методи синтези боросилікофосфатних нанокомпозитів. Виконано дослідження структури, діелектричних властивостей і провідности в боросилікофосфатних органо-неорганічних системах різного складу. Показано, що структура досліджуваних систем може бути охарактеризованою в рамках фрактального підходу. Проаналізовано вплив сполук бору на структуру і провідність простого струму нанокомпозитів.

The synthesis methods for borosilicaphosphate nanocomposites are developed based on sol-gel technology. The structure, dielectric properties and conductivity in borosilicaphosphate organic-inorganic systems of different compositions are studied. As shown, the structure of such systems can be described within the scope of the fractal approach. Influence of borides on the structure and d.c. conductivity of nanocomposites is analysed.

На основе золь-гель-технологии разработаны методы синтеза боросиликофосфатных нанокомпозитов. Проведено исследование структуры, диэлектрических свойств и проводимости в боросиликофосфатных органонеорганических системах различного состава. Показано, что структура исследуемых систем может быть охарактеризована в рамках фрактального подхода. Проанализировано влияние соединений бора на структуру и проводимость постоянного тока нанокомпозитов.

Ключові слова: золь-ґель-технології, боросилікофосфатні нанокомпозити, мало- та ширококутова Рентґенова дифрактометрія, йонна провідність.

57

(Отримано 1 грудня 2008 р.)

#### 1. ВСТУП

Створення нових матеріялів з прогнозованими характеристиками є однією з ключових задач сучасного матеріялознавства. Одним із найбільш перспективних напрямів одержання якісно нових матеріялів з підсиленими реґульованими характеристиками є нанотехнології. За своїм визначенням нанотехнології — це такі технології виробництва устаткування і їх компонентів, що дозволяють проводити маніпуляції атомами, молекулями або частинками розміром в межах від 1 до 100 нм. З точки зору розроблення метод одержання систем такого типу, тобто наносистем, останнє означає одержання наноструктурованих систем з інваріантною структурою на нанорівні. Одним із основних напрямків одержання наноструктурованих систем на сьогодні є одержання органо-неорганічних нанокомпозитів з використанням золь-тель-технології [1, 2]. Використання золь-тельтехнології дозволяє ввести в неорганічну сітку органічні молекулі, які можуть бути об'єднані на молекулярному рівні у різних співвідношеннях, що дозволяє формувати гібридні органо-неорганічні нанокомпозиційні матеріяли різного складу [3]. Більшість золь-ґельсистем проявляють властивості, притаманні фрактальним об'єктам.

На даний час встановлено, що фрактальний характер аґреґації є характерним для більшости силікатних золь-ґель-систем, неорганічних золь-тель-систем іншої природи та для відповідних органо-неорганічних золь-ґель-матеріялів [4, 5]. Показано також, що в залежності від природи органічних і неорганічних компонентів гібридних систем їх механічні властивості можуть змінюватися від крихкого до еластичного кавучукоподібного типу, що у свою чергу суттєво впливає на їх функціональні властивості. Раніше було встановлено, що силікофосфатні золь-ґель-нанокомпозити, одержані з використанням водноспиртових розчинів тетраетоксісилану (ТЕОС) і ортофосфорної кислоти можна розглядати в якості перспективних протонних провідників для електрохемічного обладнання різного типу [6]. Але мало відомо про особливості структурної організації тих матеріялів, про залежність функціональних властивостей, зокрема, провідности, від складу вихідних реакційних сумішей і типу модифікаторів. В даній роботі наведено результати досліджень впливу сполук В, а саме триметилборату (ТМБ) і борної кислоти (БК) на структуру, діелектричні властивости і провідність боросилікофосфатних нанокомпозитів.

## 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Золь-тель-синтезу проводили з використанням водно-спиртових роз-

чинів тетраетоксисилана (ТЕОС) і ортофосфорної кислоти у відповідності з методикою описаною в [7]. Для синтези використовувались тетраетоксисилан (ТЕОС), ортофосфорна кислота ( $H_3PO_4$ ), етанол (в якості розчинника), а також HCl в якості каталізатора. Після гомогенізації і наступного гідролізу на певному етапі синтези у реакційну суміш добавляли також додаткові модифікатори, такі як борна кислота (БК), фосфорна кислота, триметилборат (ТМБ) та гліцерин (ГЛ). Схему синтези гібридних силікофосфатних золь-ґель-мембран наведено на рис. 1, склади реакційних сумішей подано в табл. 1. Сполуки бору використовувались з метою покращення гідролітичної стійкости та термостабільности силікофосфатних систем. Одержані ксероґелі сушили у вакуумі при 353 К протягом 24 г. Синтезовані зразки відрізнялись один від одного як співвідношенням вихідних компонентів, так і послідовністю введення основних компонентів в реакційну суміш в процесі синтези ґелів.

Висушені ксероґелі подрібнювали до розмірів частинок 10–15 мкм. Для рентгеноґрафічних експериментів їх розміщували в кювети товщиною 0,2–0,3 мм з вікнами з лавсану товщиною 0,017 мм. Зразки для діелектричної спектроскопії готували пресуванням таблеток діяметром 16 мм и товщиною 0,05 мм з порошків ксероґелів, в які вводили полімерну основу з 10% етилацетатного розчину.

Ширококутові Рентґенові дослідження проводили на дифрактометрі ДРОН-2.0 у випроміненні мідної аноди з ніклевим фільтром на первинному жмуті. Реєстрація даних проводилась в режимі покроко-



Рис. 1. Схема синтези боросилікофосфатних нанокомпозитів.

Шифр зразка	TEOC	$H_3PO_4$	$C_2H_5OH$	Гліцерин	$H_3BO_3$	TMB
БК-0,2	1	1,5	6	0,6	0,2	_
БК-0,4	1	1,5	6	0,6	0,4	
БК-1,6	1	1,5	6	0,6	1,6	
ГЛ-0,6	1	1,5	6	0,6	1,6	
ГЛ-3	1	1,5	6	3	1,6	
ГЛ-6	1	1,5	6	6	1,6	
ТМБ-0,3	1	3,3	1,5	—	—	0,3
TMB-1	1	3,3	1,5	—	_	1,0
ТМБ-2	1	3,3	1,5		_	2,0

**ТАБЛИЦЯ** 1. Склад реакційних сумішей боросилікофосфатних нанокомпозитів.

\*Кількість речовини приведена в молях.

вого сканування сцинтиляційного детектора в діяпазоні кутів розсіяння від 5 до 30°, що відповідає інтервалу значень хвильового вектора q від 1,4 до 41 нм<sup>-1</sup>. Для більш глибокої аналізи структури даних систем окрім методи ШКРР використовували також методу малокутового Рентґенового розсіяння (МКРР). Криві малокутового розсіяння одержували в вакуумній камері типу Кратки у випроміненні Си $K_{\alpha}$ [8]. Зйомка проводилась в режимі багаторазового покрокового сканування сцинтиляційного детектора в діяпазоні кутів розсіяння від 0,03 до 4,0°, що відповідає величинам q від 0,022 до 2,86 нм<sup>-1</sup>. Це забезпечувало можливість вивчення структурних особливостей з характеристичними розмірами від 2 до 280 нм. Загальний інтервал хвильових векторів, в межах якого вивчалась інтенсивність розсіяння Рентґенових променів, становив біля трьох декад.

Попереднє оброблення рент'енографічних даних складалось із видалення фонового розсіювання, нормування розсіяної інтенсивности та введення колімаційних поправок. Для моделювання профілів малокутового Рент'енового розсіяння використовували підхід, заснований на принципах фрактальної геометрії [9]. Вимірювання діелектричних характеристик боросилікофосфатів проводили в області температур від  $-40^{\circ}$ С до  $140^{\circ}$ С в частотному діяпазоні  $10^2-10^5$  Гц з використанням діелектричної спектроскопії реалізованої на базі моста перемінного струму Р5083. Значення провідности перемінного струму визначали по стандартній методиці [10].

#### 3. РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

Результати ширококутового Рентґенового розсіяння (ШКРР) засвідчили аморфний характер близького впорядкування боросилікофосфатних систем, що є типовим для золь-ґель-систем подібного



Рис. 2. Криві МКРР боросилікофосфатних нанокомпозитів. Нумерація зразків як в табл. 1. Експериментальні дані представлені кружечками, результати моделювання рівнання (1) — суцільними лініями. Над лінійними ділянками кривих вказані відповідні значення нахилів.

типу [11]. Аналіза структурних параметрів, розрахованих із даних ШКРР, показала, що останні проявляють слабку залежність від зміни співвідношення компонентів вихідних реакційних сумішей та порядку їх змішування. Детально аналізу результатів ШКРР представлено в [12]. Для більш глибокої аналізи структури даних систем, окрім методи ШКРР, використовували також методу малокутового Рентґенового розсіяння (МКРР). Криві МКРР для боросилікофосфатів різного складу подано на рис. 2, де наведені криві згруповані в залежности від варіації концентрації того чи іншого модифікатора, відповідно, борної кислоти (рис. 2, *a*), гліцерину (рис. 2, *б*) та триметилборату (рис. 2, *в*).

З кривих рис. 2 випливає, що всі вони відповідають області Порода і характеризуються наявністю двох ділянок лінійного ходу інтенсивности. Як відомо, основою для висновку про фрактальний характер структури речовини є наявність в залежності інтенсивности розсіяння від хвильового вектора, поданої у подвійному логаритмічному масштабі, лінійної ділянки протяжністю біля однієї декади. З рисунку 2 видно, що така протяжність лінійного ходу характерна, в цілому, для ділянок, які відповідають обом структурним рівням, перший з яких характеризується наногетерогенностями, розміри яких не перевищують 10–100 нм. Мінімальні розміри спостережених наногетерогенностей відповідають максимальному значенню хвильового вектора, яке тісно межує з Бреґґовою областю і обмежене знизу значеннями характеристичної довжини біля 2 нм. Друга лінійна ділянка відповідає поведінці великомасштабних аґреґатів, розміри яких виходять за межі зони інформації малокутової Рентґенової камери (більше 500 нм). З кривих рис. 2 видно, що для всіх досліджуваних зразків боросилікофосфатів на першому структурному рівні формуються масово фрактальні аґреґати, фрактальні розмірності  $d_m$  яких змінюються в межах від 1,65 до 2,4. Аналіза кривих рис. 2 також показує, що на другому структурному рівні формуються аґльомерати переважно з гладкою поверхнею (нахил прямолінійних ділянок дорівнює –4), однак для кривих МКРР з різною кількістю ТМБ (рис. 2, в) спостерігається незначне відхилення від цього значення.

Для більш детальної аналізи результатів МКРР, а також розрахунку характерних розмірів структурних гетерогенностей боросилікофосфатів використовували узагальнене рівнання Бюкейджа [13, 14]:

$$I(q) = \sum_{i=1}^{n} \left[ G_i \exp\left(-q^2 R_{g_i}^2 / 3\right) + B_i \exp\left(-q^2 R_{g_{(i+1)}}^2 / 3\right) \left\{ \left[ \operatorname{erf}(q R_{g_i} / 6^{1/2}) \right]^3 / q \right\}^{-P_i} \right],$$
(1)

де  $G_i$  — коефіцієнт при відношенні Ґіньє для рівня I;  $B_i$  — коефіцієнт при множнику Порода для ступеневої залежности логаритму інтенсивности від логаритму хвильового вектора.  $P_i$  — експонента, яка ви-

**ТАБЛИЦЯ 2.** Режими фрактальної поведінки та параметри підгонки експериментальних кривих МКРР у рівнання (1).

Зразок	$d_{m}$	$R_{g_1}$ , нм	$d_s$	$R_{g_2}$ , нм
БК-0,2	1,6	90	2	1450
БК-0,4	1,65	115	2	1800
БК-1,6	1,8	105	2	1050
ГЛ-0,6	1,8	105	2	950
ГЛ-3	1,75	115	2	1530
ГЛ-6	1,8	105	2	1050
ТМБ-0,3	2	310	2,4	1050
ТМБ-1	2,2	210	2,8	1000
ТМБ-2	2,4	180	2	1000

значає фрактальну розмірність аґреґатів на рівні *i*. У випадку масово фрактальної поведінки нахил прямолінійних ділянок змінюється в межах 1 < P < 3. У даному випадку фрактальна розмірність визначається як  $d_m = P = |x| (x$  — танґенс кута нахилу прямолінійної ділянки). Для поверхневих фракталів нахил змінюється в межах 3 < P < 4. ). У даному випадку фрактальна розмірність визначається як  $d_s = 6 - P$ .

Розраховані з використанням рівнання (1) параметри структурної аґреґації боросилікофосфатів різного складу наведені в табл. 2.

Аналіза наведених у табл. 2 результатів показує, що системи з найбільш «пухкою» структурою спостерігаються для боросилікофосфатів з мінімальним вмістом (0,2 моль на 1 моль ТЕОС) борної кислоти. Дані системи характеризуються найменшими значеннями  $d_m = 1,6$  та найменшим розміром масово-фрактальних аґреґатів  $R_{g1} = 90$  нм. Збільшення концентрації БК дещо ущільнює аґреґати  $(d_m = 1,8$  для БК-1,6) і збільшує розміри аґреґатів до 115 нм (БК-0,4). Варіяція концентрації гліцерину практично не впливає на структурні характеристики досліджуваних систем, тоді як модифікування силікофосфатів триметилборатом значно ущільнює структуру масо-



Рис. 3. Ізотерми провідности перемінного струму боросилікофосфатних нанокомпозитів. Нумерація зразків та склад як в табл. 1.

во-фрактальних аґреґатів ( $d_m = 2,4$  для ТМБ-2), а також значно збільшує їх розміри до 200–300 нм.

На рисунку 3 наведені температурні залежності провідности прямого струму  $\sigma_{dc}$  боросилікофосфатів різного складу. Аналіза кривих свідчить, що всі боросилікофосфатні системи характеризуються високими рівнями провідности  $\sigma_{dc} = 10^{-4} - 10^{-2}$  См/см при температурах вище 100°С. Тип модифікатора та його вміст дозволяє змінювати  $\sigma_{dc}$  в межах двох порядків величини. Найбільшими рівнями провідности  $\sim 10^{-2}$  См/см при термостійкості за температур вищих 100°С характеризуються боросилікофосфатні системи модифіковані ТМБ.

Таким чином, проведені рентґеноструктурні дослідження боросилікофосфатів різного складу показують, що структура досліджених систем подібного типу може бути охарактеризована в рамках фрактальної геометрії. В залежности від складу та умов синтези фрактальні розмірності змінюються з  $d_m = 1,65$  до  $d_m = 2,4$ . Показано, що всі системи характеризуються високими рівнями провідности, що робить їх перспективними для використання в якості твердих електролітів для різного електрохемічного устаткування.

### ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- 1. S. H. Phillipps, T. S. Haddad, and S. J. Tomczak, *Cur. Op. Solid State Mater*. Sci., 8: 21 (2004).
- 2. C. J. Brinker and G. W. Scherer, *Sol-Gel Science. The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing* (San Diego: Academic Press: 1990).
- 3. G. Kickelbick, *Progr. Polym. Sci.*, **28**: 83 (2003).
- 4. D. W. Schaefer and K. D. Keefer, Phys. Rev. Lett., 53: 1383 (1984).
- 5. A. C. Geiculescu and H. J. Rack, *Phys. Rev.*, 306: 20 (2002).
- 6. F. M. Gray, *Polymer Electrolytes. RSC Materials Monographs* (London: The Royal Society of Chemistry: 1997).
- 7. A. Matsuda, K. Hirata, M. Tatsuminago, and T. Minami, J. Ceram. Soc. Japan, 45: 108 (2000).
- 8. Ю. С. Липатов, В. В. Шилов, Ю. П. Гомза, Н. Е. Кругляк, *Рентгенографиче*ские методы изучения полимерных систем (Киев: Наукова думка: 1982).
- 9. D. W. Schaefer, J. E. Martin and K. D. Keefer, *Physics of Finely Divided Matter* (Eds. N. Bocarra and M. Daoud) (Berlin: Springer-Verlag: 1985), p. 31.
- 10. A. Kyritsis, P. Pissis, and J. Grammatikakis, J. of Polymer Science. Part B: Polymer Physics, 33: 1737 (1995).
- 11. А. П. Шпак и др., Диагностика наносистем. Многоуровневые фрактальные наноструктуры (Киев: Академпериодика: 2004).
- 12. В. В. Клепко, Ю. П. Гомза, С. Д. Несін, В. П. Сорочинський, Фізика конд. високомол. систем, вип. 12: 60 (2007).
- 13. G. Beaucage, J. Appl. Cryst., 28: 717 (1995).
- 14. G. Beaucage, J. Appl. Cryst., 29: 134 (1996).